



深圳市浪拓電子技術有限公司
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

SiBar 晶閘管浪涌抑制器

SiBar 半导体浪涌保护元件能够保护敏感的电信设备和数据通信设备,防止雷击瞬态电压等过电压事件造成损坏,在浪涌电压超过击穿电压时起分流的作用.当电压超过击穿电压时,SiBar 半导体浪涌抑制器工作在保护特性曲线的低阻区,形成一个低阻通路,有效地降低过电压.

SiBar 半导体浪涌保护元件符合 GR-1089 Core、ITU K. 20/K. 21、IEC61000-4-5、FCC 第 68 章以及 UL60950 等主要标准,可以对模拟和数字线路卡, XDSL 和 ISDN 调制解调器、机顶盒、T1 设备、VoIP 设备和 PoE 设备实现快速的双向保护.



型号	断态电压		转折电压		通态压降		维持电流	极间电容
	VDRM	IDRM	VS	IS	VT	IT	IH	CO
	V	μ A	V	mA	V	A	mA	pF
		MAX	TYPE	MAX	MAX		MIN	MAX
LT-BS0060MS-SMART	5	5	20	800	4	1	40	40

SiBar 元件与能量处理等级相同的 位器件相比,具有更低导通电压和更小的体积,且电容小,适合应用于高速数据传输的电路中.

特性

- 符合 RoHS 标准要求
- 双向瞬变电压保护
- 截止时呈高阻状态
- 导通时呈低阻状态
- 浪涌吸收能力高
- 新低电容和微电容器件
- 提供更广的电压范围 (6V~400V)
- 短路故障模式
- 表面贴装技术